

平成 29 年度 基盤研究 (S) 審査結果の所見

研究課題名	layer transfer による高移動度材料 3 次元集積 CMOS の精密構造制御
研究代表者	高木 信一 (東京大学・大学院工学系研究科 (工学部)・教授) ※平成 29 年 6 月末現在
研究期間	平成 29 年度～平成 33 年度
コメント	<p>本研究は、エレクトロニクスの根幹をなす CMOS 技術の更なる進展に正面から取り組もうとするものであり、高移動度材料を上下に積み重ねて 3 次元集積化する layer transfer 技術を中心に、ソース、ドレインの低抵抗化や界面物性制御など総合的な基盤技術の開発を目指すもので、学術上も産業応用上も重要である。</p> <p>応募者は、これまで CMOS デバイス分野で国際的に評価の高い優れた研究実績があり、本研究を遂行して十分な研究成果を上げることが期待される。</p> <p>以上の理由により、基盤研究 (S) として推進することが適当と判断した。</p>